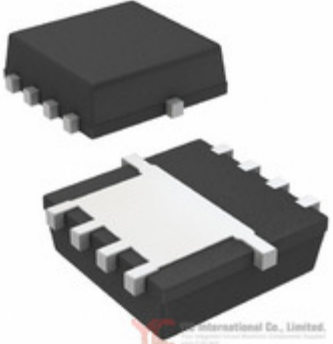

	<h2 style="color: red;">SQS850EN-T1_GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SQS850EN-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 12A POWERPAK1212
	Datenblätter:  SQS850EN-T1_GE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

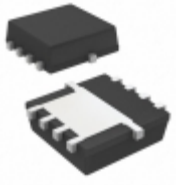
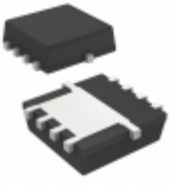
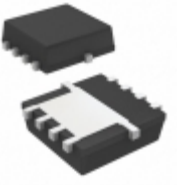





Spezifikationen

Teilenummer	SQS850EN-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 12A POWERPAK1212
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21.5 mOhm @ 6.1A, 10V
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2021pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 12A (Tc) 33W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SQS850EN-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQS850EN-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQS850EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQS850EN-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQS484ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 16A POWERPAK1212</p>	 <p>SQS840EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 16A TO263</p>	 <p>SQS484EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 16A 1212-8</p>	 <p>SQS840EN-T1-GE3 VISHAY SQS840EN-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SQS840EN-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 16A TO263</p>	 <p>SQS944ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V</p>	 <p>SQSA80ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 18A POWERPAK1212</p>	 <p>SQS850EN-T1-GE3 SIGNAQUES SQS850EN-T1-GE3 SIGNAQUES</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQS850EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQS850EN-T1_GE3 Datenblatt	SQS850EN-T1_GE3-Datenblätter	SQS850EN-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQS850EN-T1_GE3 Electronic	SQS850EN-T1_GE3-Komponenten	SQS850EN-T1_GE3-Verteiler	SQS850EN-T1_GE3-Bild	SQS850EN-T1_GE3
SQS850EN-T1_GE3 Preis	SQS850EN-T1_GE3 Hersteller	SQS850EN-T1_GE3 Bild	SQS850EN-T1_GE3 Aktie	SQS850EN-T1_GE3-Teil
SQS850EN-T1_GE3 Neu	SQS850EN-T1_GE3 Original	SQS850EN-T1_GE3 garantiert	SQS850EN-T1_GE3 RFQ	SQS850EN-T1_GE3 Inventar
				SQS850EN-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited